

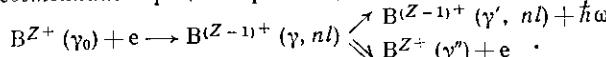
тельны к свету,  $\alpha$ -частицам,  $\gamma$ -излучению, высокознергетичным малозарядным частицам. Д. д. обеспечивают возможность регистрации заряженных частиц при высоких и низких температурах, в химически агрессивных средах, при высоких давлениях, ударных нагрузках и в высоком вакууме. Д. д., покрытые слоем  $^{235}\text{U}$ ,  $^{238}\text{U}$ , применяются для регистрации тепловых и быстрых нейтронов по осколкам деления. В состав Д. д. могут быть введены любые необходимые элементы от Li до U.

Основные применения Д. д.: регистрация факта прохождения частицы (регистрация осколков деления, измерение потоков нейтронов, дозиметрия, радиография и др.); использование высокого пространств. разрешения при исследовании деления ядер на 3 и более осколков и измерении времён жизни составных ядер методом «степей»; определение  $Z$  и  $A$  релятивистских ядер по изменению скорости травления вдоль следа.

С помощью Д. д. были идентифицированы трансуранные элементы от  $A=103$  до  $A=107$ , открыты явления запаздывающего деления ядер из изомерных состояний, деления ядер на 3 осколка, в космических лучах обнаружены ядра тяжелее Fe.

Лит.: Флеров Г. Н., Берзина И. Г., Радиография минералов, горных пород и руд, М., 1979; Гангрский Ю. П., Марков В. Н., Перерывы гин В. П., Регистрация и спектрометрия осколков деления, М., 1981; Флайшер Р. Л., Прайс П. Б., Уокер Р. М., Треки заряженных частиц в твердых телах. Принципы и приложения, пер. с англ. ч. 1—3, М., 1981.

**ДИЭЛЕКТРОННАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ** — процесс рекомбинации ионов и электронов в плазме, связанный с образованием промежуточных атомоионизационных состояний. Процесс происходит в две стадии:



На первой — падающий электрон ( $e$ ) возбуждает рекомбинирующий ион  $B^{Z+}(\gamma_0)$  ( $Z$  — кратность иона,  $\gamma_0$  — набор квантовых чисел его нач. состояния,  $n, l$  — квантовые числа присоединённого электрона) и образуется промежуточное автоионизац. состояние иона  $B^{(Z-1)+}$  с кратностью на единицу меньше и квантовыми числами  $\gamma, nl$ . На второй стадии происходит распад автоионизац. состояния. Если в результате распада излучается фотон с энергией  $h\nu$  и получается обычное стационарное состояние иона  $\gamma', nl$  (показано одинарной стрелкой), то произошла рекомбинация, если же в результате распада получится снова свободный электрон и ион  $B^{Z+}$  в состоянии  $\gamma''$  (показано двойной стрелкой), то произошло резонансное рассеяние (упругое, если  $\gamma_0 = \gamma'$ , и неупругое в противном случае).

Впервые на важность процесса Д. р. было указано А. Бёрджессом [1, 2]. Д. р. играет определяющую роль в ионизационном равновесии многозарядных ионов в горячей разреженной плазме ряда астрофиз. объектов (короны звёзд, остатки вспышек сверхновых и др.) и лаб. установок (типа «Токамак», «Стелларатор» и др.).

Д. р. имеет след. осн. особенности. 1) Так же, как и для фоторекомбинации, число актов Д. р. в единицу времени в единице объёма  $N$  пропорц. плотности рекомбинирующих ионов  $N_Z$  и первой степени электронной плотности  $N_e$  (отличие от трёхчастичной рекомбинации, пропорц.  $N^2$ ):  $N = N_Z \cdot N_e \propto_d$ , где  $\propto_d$  — скорость Д. р. 2) Процесс Д. р. связан с возбуждением электронов рекомбинирующего иона, поэтому Д. р. принципиально невозможна для голых ядер. Т. к. обычно потенциал возбуждения существенно больше  $kT$  ( $T$  — темп-ра плазмы), то число максвелловских электронов с энергией большие потенциала возбуждения мало и скорость Д. р. экспоненциально зависит от  $T$ . 3) Осн. вклад в Д. р. дают, как правило, состояния с большими квантовыми числами  $(n, l)$ . Эти состояния легко разрушаются столкновениями с заряж. частицами, полем внеш. излучения и др. факторами, поэтому скорость Д. р. имеет значительно более сильную зависимость от параметров плазмы, чем, напр., скорость фо-

торекомбинации. 4) Излучаемые в процессе Д. р. кванты  $\hbar\omega$  имеют строго определённые значения энергии, равные энергии перехода  $(\gamma, nl) \rightarrow (\gamma', nl)$  в ионе  $B(Z-1)^+$ . Соответствующие им спектральные линии наз. ди- алектронными сателлитами.

Гл. трудность в расчёте скорости Д. р. состоит в необходимости учёта большого числа промежуточных состояний. Для приложений скорость Д. р. обычно аппроксимируют выражением:

$$\chi_d = 10^{-13} B \beta^{3/2} e^{-\beta x} \text{ cm}^3/\text{c}; \quad \beta = \frac{(Z+1)^2 \text{ Ry}}{kT}.$$

Параметры  $B$  и  $\chi$ , вообще говоря, должны рассчитываться индивидуально для каждого иона,  $Ry=13,6$  эВ — единица Ридберга для энергии. Подробная теория Д. р., включая ф-лы для расчёта параметров  $B$ ,  $\chi$  и их значения для нек-рых типов ионов, приведена в [2]. Часто используют полуэмпирич. ф-лу:

$$B = 480 f_{\gamma_0 \gamma} \left( \frac{Z \epsilon}{Z^2 + 13,4} \right)^{1/2} [1 + 0,105 (Z+1) \chi + \\ + 0,015 (Z+1)^2 \chi^2]^{-1};$$

$$\epsilon = \frac{E_{\gamma_0 \gamma}}{(Z-1) \cdot m_e c^2}; \quad \chi = \epsilon \cdot \left[ 1 + 0,015 \frac{Z^3}{(Z-1)^2} \right]^{-1},$$

где  $E_{\gamma_0\gamma}$ ,  $f_{\gamma_0\gamma}$ —соответственно энергия и сила осциллятора перехода  $\gamma_0 \rightarrow \gamma$ .

Лит.: 1) *Vuggess A., A general formula for the estimation of dielectronic recombination coefficients in low density plasmas*, «Astrophys. J.», 1965, v. 141, p. 1583; 2) *Vuggess A., Dielectronic recombination and the temperature of the solar corona*, «Astrophys. J.», 1964, v. 139, p. 778; 3) *Вайнштейн Л. А., Собельман И. И., Юков Е. А., Возбуждение атомов и уширение спектральных линий*, М., 1979. — И. Л. Бейгман.

**ДЛИНА РАССЕЯНИЯ** — величина, характеризующая поведение амплитуды упругого рассеяния частиц при малых энергиях (импульсах). Введена Э. Ферми (E. Fermi). Для короткодействующих потенциалов амплитуда  $f_l$  рассеяния беспринциповых частиц в состоянии с орбитальным моментом  $l$  при

$$p \ll \frac{\hbar}{r_0} \quad (1)$$

( $p$  — относит. импульс частиц,  $r_0$  — характерный размер области взаимодействия) имеет вид:

$$f_l = -a_l p^{2l}. \quad (2)$$

Вещественная константа  $a_l$  наз. Д. р. Если выполняется условие (1), то осн. роль играет рассеяние в состоянии с  $l=0$  ( $S$ -волна) и для амплитуды имеем:

$$f \Big|_{k \rightarrow 0} = \frac{1}{k \operatorname{ctg} \delta - ik} \Big|_{k \rightarrow 0} = -a, \quad (3)$$

где  $\delta$  и  $a$  — фаза и длина  $S$ -рассеяния,  $k = p/\hbar$  — волновое число. Т. о.,

$$k \operatorname{ctg} \delta \Big|_{k \rightarrow 0} = -\frac{1}{a}. \quad (4)$$

Дифференц. сечение рассеяния определяется в области малых энергий длиной рассеяния:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \Big|_{k \rightarrow 0} = a^2. \quad (5)$$

Соотношение (4) представляет собой первый член разложения по  $k^2$  величины  $k \operatorname{ctg} \delta$ . След. член характеризуется эффективным радиусом рассеяния. Длина  $S$ -рассеяния зависит от полного спина и полного изотопического спина рассеиваемых частиц. Если система рассеиваемых частиц обладает уровнем с малой энергией связи, то Д. р. связана с энергией связи  $E_{\text{св}}$  соотношением (Ф-ла Вигнера):

$$\frac{\hbar}{a} = \sqrt{2\mu E_{CB}} \quad (6) \text{ 703}$$